

Transport

Jeśli mamy dodatkowy potencjał (np. pole elektryczne), to **NIE MA** symetrii translacyjnej $\Rightarrow \vec{k}$ przestaje być dobrą liczba kwantową, stany blochowskie nie są już funkcjami własnymi hamiltonianu (chociaż zawsze rozwiązań możemy poszukiwać w postaci ich kombinacji liniowej – w ogólności zależnej od czasu)

 $\vec{F} = \hbar \vec{k}$

zmiana \vec{k} – przejścia pomiędzy stanami blochowskimi, stany o określonym \vec{k} nie są już stanami własnymi hamiltonianu

$$\begin{cases} \frac{1}{2m} \left[\hat{p} - q \vec{A}(\vec{r}, t) \right]^2 + q \varphi(\vec{r}, t) + U(\vec{r}, t) \right\} \psi(\vec{r}, t) = i\hbar \frac{d}{dt} \psi(\vec{r}, t) \\ \hline Ped \text{ kanoniczny } \hat{p} \text{ Suma: ped kinetyczny } \vec{B} = \nabla \times \vec{A}^* \quad \vec{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \hline Równanie ciągłości \qquad J(\vec{r}, t) = \frac{\hbar q}{2 i m} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) - \frac{q}{m} |\Psi|^2 \vec{A}(\vec{r}, t) \\ albo: \\ J(\vec{r}, t) = \frac{q}{2} \left[\Psi^* \left(\frac{\hat{p} - q \vec{A}(\vec{r}, t)}{m} \Psi \right) + \left(\frac{\hat{p} - q \vec{A}(\vec{r}, t)}{m} \Psi \right)^* \Psi \right] \\ \text{M. Ba} \\ D13-06-02 \end{cases}$$

Transport

Jednoelektronowe równanie Schrödingera: $\begin{pmatrix} \hat{p}^2 \\ 2m \end{pmatrix} \psi(\vec{r}) = E\varphi(\vec{r}) \\
\text{Jeśli potencjał jest periodyczny, to dobrymi rozwiązaniami są funkcje Blocha:} \\
\varphi_{n,\vec{k}}(\vec{r}) = u_{n,\vec{k}}(\vec{r}) \cdot \exp(i\vec{k}\cdot\vec{r}) \\
\text{Wektor falowy } \vec{k} (a więc i kwazipęd h\vec{k}) jest dobrą "liczbą" kwantową. Prędkość grupowa elektronu:$ $<math display="block">\vec{v} = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} E(\vec{k}) \\
\text{Ze względu na symetrię pasm: } E_n(\vec{k}) = E_n(-\vec{k})(\text{ogólniej } E_n^{\dagger}(\vec{k}) = E_n^{\dagger}(-\vec{k})), jeśli funkcja rozkładu zależy tylko od energii (w równowadze termodynamicznej), to nie ma żadnych przepływów (transportu). \\
M. Baj.$



2013-06-02

Rozproszenia elastyczne i nieelastyczne Zachowanie kwazipędu $\vec{k} = \vec{k}' \pm \vec{q} + \vec{G}$ Zachowanie energii $E_{n,\vec{k}} = E_{n,\vec{k}}, \pm E_{\vec{q}}$ gdzie \vec{q} i $E_{\vec{q}}$ - kwazipęd i energia pochłoniętej/emitowanej kwazicząstki

Jeśli w rozproszeniu **nie uczestniczy żadna kwazicząstka** (np. fonon) lub jej energia jest w bilansie do zaniedbania (w porównaniu z kT i średnią energią układu elektronów), to rozproszenie jest elastyczne (lub w przybliżeniu elastyczne).

Przy rozproszeniach wewnątrzpasmowych n = n', jeśli pasmo jest sferyczne, to: $|\vec{k}| = |\vec{k}'|$

Rozproszenia elastyczne – np. na potencjałach domieszek i defektów

M. Baj.

Rozpraszanie

Rozproszenia elastyczne i nieelastyczne

Rozproszenia nieelastyczne – np. na fononach (lub innych kwazicząstkach). W przybliżeniu często traktuje się rozpraszanie na fononach akustycznych jako elastyczne (bo energie fononów akustycznych są niewielkie). Nawet rozpraszanie na fononach optycznych często opisuje się przy założeniu, że rozproszenia są w przybliżeniu elastyczne (w odpowiednio wysokich temperaturach, w których $kT \gg \hbar\omega_0$).













2013-06-02

Rozproszenia elastyczne i nieelastyczne

Czas kwantowy τ_a , średnia droga swobodna l_a

Każde rozpraszanie prowadzi do tego, że czas życia w danym stanie kwantowym (tzw. "czas kwantowy") jest skończony i poszerzenie $\Delta E \neq 0$. Średnia droga swobodna: $l_a = v_F \tau_a$

Czas transportowy (czas relaksacji pędowej) au_{tr} , średnia droga swobodna l_{tr}

W makroskopowych przepływach elektronów (np. prąd elektryczny) liczy się nie sam fakt rozproszenia, ale jak w rozproszeniu zmienia się pęd (wektor falowy). Niskokątowe rozproszenia mają mniejszy wpływ na relaksację pędu niż wysokokątowe (rozproszenia elektron-elektron nie dają wkładu do τ_{tr}):

$$\frac{1}{\tau_q} = \int P(\theta) \, d\Omega$$
$$\frac{1}{\tau_{rr}} = \int P(\theta) \, (1 - \cos \theta) d\Omega$$

gdzie θ – kąt (elastycznego) rozproszenia. Przeważnie $\tau_{tr} > \tau_q$.

M. Bai

Rozproszenia elastyczne i nieelastyczne

Czas transportowy (czas relaksacji pędowej) au_{tr} , średnia droga swobodna l_{tr}

W makroskopowych przepływach elektronów (np. prąd elektryczny) liczy się nie sam fakt rozproszenia, ale jak w rozproszeniu zmienia się pęd (wektor falowy). Niskokątowe rozproszenia mają mniejszy wpływ na relaksację pędu niż wysokokątowe (rozproszenia elektron-elektron nie dają wkładu do τ_{tr}):

$$\frac{1}{\tau_q} = \int P(\theta) \, d\Omega$$
$$\frac{1}{\tau_{tr}} = \int P(\theta) \, (1 - \cos\theta) d\Omega$$

gdzie θ – kąt (elastycznego) rozproszenia. Przeważnie $\tau_{tr} > \tau_q$

Ruchliwość - czas transportowy :

$$\mu = \frac{e\tau_{tr}}{m^*}$$

Przykład: GaAs, $\mathrm{m}^*~pprox~0,067~m_0$, $E_F=~10$ meV, $v_Fpprox 2,3\cdot 10^5$ m/s

1. T = 300 K, materiał objętościowy: $\mu \approx 4000$ cm²/Vs, $\tau_{tr} \approx 0.15$ ps, $\tau_{tr}v_F = l_{tr} \approx 35$ nm

M. Bai

2. T = 1 K, 2DEG: $\mu \approx 10^7$ cm²/Vs, $\tau_{tr} \approx 400$ ps, $\tau_{tr} v_F = l_{tr} \approx 90$ μ m

2013-06-02

Rozpraszanie

Czas relaksacji fazy (czas koherencji fazowej) τ_{φ} , długość relaksacji fazy (długość koherencji fazowej) l_m

Rozproszenia mogą prowadzić do przypadkowych zmian fazy funkcji falowej elektronu, a więc zaniku jej spójności fazowej, co z kolei uniemożliwia efektywną interferencję. Spójność fazową niszczą rozproszenia nieelastyczne. W relaksacji fazy nie biorą udziału "sztywne rozpraszacze", a tylko "fluktuujące" (rozpraszanie na fononach, rozpraszanie elektron-elektron, rozpraszanie na domieszkach z "wewnętrznymi stopniami swobody")

Przykład 1 – efekt Aharonova-Bohma

Elektron poruszający się z punktu 1 do punktu 2 po pewnej drodze *P*, na której nie znika potencjał wektorowy \vec{A} ($\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$) doznaje przesunięcia fazowego:



Rozpraszanie

Rozproszenia elastyczne i nieelastyczne

Czas relaksacji fazy (czas koherencji fazowej) τ_{φ} , długość relaksacji fazy (długość koherencji fazowej) l_{a}

(2)

Przykład 1 – efekt Aharonova-Bohma

$$\Delta \varphi_{12} = \frac{e}{\hbar} \left(\int_{(1)} \vec{A} \, d\vec{r} - \int_{(2)} \vec{A} \, d\vec{r} \right) = \frac{e}{\hbar} \int_{S} \vec{B} \, d\vec{S} = \frac{e}{\hbar} \Phi_{B}$$
elastic scattering
Różnica faz pomiędzy dwiema różnymi drogami jest
proporcjonalna do strumienia pola \vec{B} przez
powierzchnię *S* rozpiętą przez obie drogi.

Zachodzi interferencja fal elektronowych poruszających się po obu drogach. Prawdopodobieństwo transmisji T jest okresowe z polem \vec{B} z okresem:

$$\Phi_0 = \frac{1}{\hbar}$$
$$T = 2T_0 \left[1 + \cos\left(\frac{e}{\hbar} \Phi_B + \phi_0\right) \right]$$

Amplituda maleje jak $\sim \exp(-\tau/\tau_{\varphi})$ (τ – czas przelotu przez interefromentr)

2013-06-02

Rozpraszanie

Rozproszenia elastyczne i nieelastyczne

Czas relaksacji fazy (czas koherencji fazowej) τ_{φ} , długość relaksacji fazy (długość koherencji fazowej) l_{φ}

Przykład 2 – słaba lokalizacja

Przypadkowo rozłożone rozpraszacze (elastyczne) umożliwiają wystąpienie rozpraszania do tyłu, którego prawdopodobieństwo jest zwiększone ze względu na interferencję konstruktywną pomiędzy dwiema drogami odpowiadającymi ruchom w przeciwne strony. Prowadzi to do zwiększenia całkowitego prawdopodobieństwa rozpraszania do tyłu, a więc zmniejszenia przewodności elektrycznej. Pole magnetyczne wprowadza przesunięcia fazowe pomiędzy obu drogami, co, ze względu na uśrednienie wkładów bardzo wielu możliwych tego typu par trajektorii, gasi efekt ⇒ ujemny magnetoopór.



Rozproszenia elastyczne i nieelastyczne Czas relaksacji fazy (czas koherencji fazowej) τ_φ, długość relaksacji fazy (długość koherencji fazowej) L_α



Rozpraszanie	70e
Czas relaksacji fazy (czas koherencji fa. fazowej) l_{φ} Przykład 3 – uniwersalne fluktuacje pr.	a) sample B-6 nanowire 10 µm
5. Alagha et al., Journal of Applied Physic	c) contacts InN wire
108 , 113704 (2010)	AuSb backgate
M. Baj.	FIG. 1. (Color online) (a) Scanning electron beam micrograph of sample B-6 with six InN wires connected in parallel and (b) detail of a contacted InN nanowire. (c) Schematic illustration of a contacted nanowire. The Si substrate used as a back-gate electrode is isolated from the nanowire by a 100 nm thick StO ₂ layer.

Rozpraszanie

Rozproszenia elastyczne i nieelastyczne

Czas relaksacji fazy (czas koherencji fazowej) τ_{φ} , długość relaksacji fazy (długość koherencji fazowej) l_{φ}

Przykład 3 – uniwersalne fluktuacje przewodności (UCF)

Przypadkowo rozłożone rozpraszacze (elastyczne) wyznaczają różne możliwe trajektorie elektronowej paczki falowej. Interferencje pomiędzy tymi trajektoriami prowadzą do zależności całkowitej przewodności od parametru mogącego modyfikować tę interferencję (np. pola magnetycznego). Zmiany te są w pełni powtarzalne. Szczegółowy obraz aperiodycznych zależności G(B) zależny jednak od rozkładu domieszek: ogrzanie i ponowne schłodzenie próbki może zmieniać szczegóły zależności G(B) – domieszki mogą trochę przedyfundować.





M. Baj.

Rozpraszanie

Rozproszenia elastyczne i nieelastyczne - podsumowanie

Czas kwantowy τ_a , średnia droga swobodna $l_a = v_F \tau_a$

Czas transportowy (czas relaksacji pędowej) τ_{tr} , średnia droga swobodna $l_{tr} = v_F \tau_{tr}$

Czas relaksacji fazy (czas koherencji fazowej) τ_{ω} , długość relaksacji fazy (długość koherencji fazowej) l_o

 $l_{\varphi} = D\tau_{\varphi}$

M. Baj

M. Bai

Jeśli $\tau_{\omega} \gg \tau_{a}$ to:

Gdzie $D = \mu k_B T/q$ – stała dyfuzji

Transport

Skale długości:

Rozmiary układu (kropki kwantowej), dla których efekty ładowania pojedynczymi elektronami mogą być widoczne

Energia ładowania pojedynczym elektronem:

$$E = \frac{e^2}{2C}$$

Pojemność "wyspy" (krążka) o promieniu R otoczonej materiałem o stałej dielektrycznej ε : $C = 8\varepsilon\varepsilon_0 R$

Aby móc obserwować efekty związane z ładowaniem pojedynczym elektronem (np. tzw. blokadę kulombowską), energia ładowania nie może być dużo mniejsza od k_BT ($E \approx k_BT$):

1. dla ε = 10, T = 300 K: $R \approx 4$ nm 2. dla ε = 10, T = 4 K: $R \approx$ 300 nm

Transport
Skale długości:
Długość fali de Broglie'a elektronu (na poziomie Fermiego)
$$\lambda_F$$
:
 $\lambda_F = \frac{2\pi}{k_F}$

Dla metalu $m^* \approx m_0$ i $E_F \approx 10 \text{eV} \Rightarrow \lambda_F \approx 0.4 \text{ nm}$ Dla półprzewodnika $m^* \approx 0.067 m_0$ (GaAs) i $E_F \approx 10 \text{meV} \Rightarrow \lambda_F \approx 47 \text{ nm}$

Łatwiej jest uzyskać efekty uwięzienia kwantowego w półprzewodnikach niż w metalach!

Długość magnetyczna l_B Promień orbity cyklotronowej najniższego poziomu Landaua:

$$\frac{1}{2}\hbar\omega_c = \frac{1}{2}m^*v^2 = \frac{1}{2}m^*\omega_c^2 l_B^2 \quad \Rightarrow \quad l_B = \sqrt{\frac{\hbar}{eB}}$$

W polu B = 1T dostajemy $l_B \approx 26$ nm

Tra

2013-06-02

Energia cyklotronowa $E_c = \hbar \omega_c$ Dla półprzewodnika $m^* \approx 0,067m_0$ (GaAs) w B = 1T $E_c \approx 1.7$ meV

Transport Skale długości: Transport elektronów przez kropki kwantowe – układ, w którym efekty ładowania muszą być widoczne (a) Lateral (b) Vertical SOURCE Quantum DRAIN Quantum Dot Dot GATE sd Vg Figure 1.1. Schematic of a quantum dot, in the shape of a disk, connected to source and drain contacts by tunnel junctions and to a gate by a capacitor. (a) shows the lateral geometry and (b) the vertical geometry. http://marcuslab.harvard.edu/papers/KouwenhovenReview.pdf M. Baj. 2013-06-02



Transport dyfuzyjny

Dyfuzyjny transport elektronowy – rozmiary układów (metale bądź półprzewodniki) dużo większe od średniej drogi swobodnej: $L\gg l_q, l_{tr}$

Problem wielu cząstek – metody fizyki statystycznej

Będziemy używać funkcji rozkładu prawdopodobieństwa obsadzeń stanów elektronowych. $f=f(\vec{r},\vec{k},t)$

Jeśli w jakiś sposób potrafilibyśmy znaleźć taką funkcję rozkładu, to bylibyśmy w stanie policzyć rozmaite przepływy, np. (3D): gęstość prądu elektrycznego

$$\vec{j}(\vec{r},t) = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{SR} \vec{v}(\vec{k}) f(\vec{r},\vec{k},t) d^3\vec{k}$$

gęstość strumienia energii (elektronowy wkład do transportu ciepła):

$$\vec{w}(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi^3} \int_{SB} \left[E(\vec{k}) - \mu \right] \vec{v}(\vec{k}) f(\vec{r},\vec{k},t) d^3\vec{k}$$

Przepis na znalezienie funkcji rozkładu $f = f(\vec{r}, \vec{k}, t)$ podał Boltzmann

R. Stępniewski.

<text><text><equation-block><text><text><text><equation-block><text><text>

Równanie Boltzmana

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f - \frac{1}{\hbar} \vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + b - a$$

równanie różniczkowo-całkowe, nieliniowe, w ogólnym przypadku niemożliwe do rozwiązania. Opis za pomocą równania Boltzmana jest opisem kwaziklasycznym – ma zastosowanie, gdy paczkę falową elektronu można w przybliżeniu traktować jak cząstkę klasyczną (wymaga podania zmiennych \vec{k} i \vec{r} - 6 niezależnych wymiarów). W stanie stacjonarnym $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$

W szczególności długość fali de Broglie'a elektronu λ musi spełniać następujące warunki:

- $\lambda \ll L$, gdzie L typowy rozmiar dla danego problemu
- $\lambda |\vec{F}| \ll \langle E \rangle$ zmiana energii E wywołana działaniem siły zewnętrznej \vec{F} na drodze λ musi być mała w porównaniu ze średnią energią
- $\lambda \ll l$, gdzie l średnia droga swobodna
- Pola (elektryczne, magnetyczne i tp). muszą być zapisane klasycznie, np. $\hbar\omega_c \ll \langle E \rangle \Rightarrow \hbar\omega_c \ll k_B T$ (przypadek niezdegenerowany) $\hbar\omega_c \ll E_F$ (dla degeneracji)

Przykład: w polu elektrycznym o natężeniu $\mathcal{E}:F=e\mathcal{E}$, dla GaAs z $E_F\approx 10$ meV $\lambda\approx 50$ nm powyższy warunek daje: $\mathcal{E}\ll 2\cdot 10^3$ V/cm - silne pole jak na przewodzące próbki makroskopowe, ale niezbyt silne z punktu widzenia układów w skali mikro (np. przyrządów półprzewodnikowych)



Równanie Boltzmana		
$\frac{\partial f}{\partial t} = -\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f - \frac{1}{\hbar}$	$\vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + b - a$	
$a = \int_{SB} W(\vec{k}, \vec{k}') [1 - f(\vec{k}')] \rho(\vec{k}') f(\vec{k}) d^3 \vec{k}'$	a – częstość zderzeń przeprowadzających elektron ze stanu $ec{k}$ do jakiegokolwiek $ec{k}'$	
$b = \int_{SB} W(\vec{k}'',\vec{k}) [1 - f(\vec{k})] \rho(\vec{k}'') f(\vec{k}'') d^3 \vec{k}''$	<i>b</i> – częstość zderzeń przeprowadzających elektron do stanu \vec{k} z jakiegokolwiek \vec{k}''	
Człon zderzeniowy równania Boltzmanna (tutaj, d zależność od położenia \vec{r}), $W(\vec{k}, \vec{k}') = W(\vec{k}', \vec{k})$:	la uproszczenia, pomijamy ewentualną	
$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{zd} = b - a = \int_{SB} \left[W(\vec{k}', \vec{k}) \left[1 - f(\vec{k})\right]f(\vec{k})\right] dt$	$(\vec{k}') - W(\vec{k}, \vec{k}')[1 - f(\vec{k}')]f(\vec{k})]\rho(\vec{k}')d^{3}\vec{k}'$	
$= -\int_{SB} W(\vec{k}, \vec{k}') \rho(\vec{k}') [f(\vec{k}) - f(\vec{k}')]$	$)]d^{3}\vec{k}'$	

2013-06-02

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= -\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f - \frac{1}{\hbar} \vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + b - a \\ \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{zd} &= b - a = \int_{SB} \left[W(\vec{k}', \vec{k}) [1 - f(\vec{k})] f(\vec{k}') - W(\vec{k}, \vec{k}') [1 - f(\vec{k}')] f(\vec{k}) \right] \rho(\vec{k}') d^3 \vec{k}' \\ &= -\int_{SB} W(\vec{k}, \vec{k}') \rho(\vec{k}') [f(\vec{k}) - f(\vec{k}')] d^3 \vec{k}' \end{aligned}$$

_{s'B} Równanie różniczkowo-całkowe, nieliniowe, w ogólnym przypadku niemożliwe do rozwiązania – w pewnych warunkach można je spróbować zlinearyzować:

Zakładamy, że funkcja rozkładu jest bliska stanowi równowagi $f = f_0 + f_1$ i zakładamy specjalną postać $f_1 = \vec{v} \cdot \vec{X}(E)$, gdzie $\vec{X}(E)$ jest funkcją wektorową zależną tylko od energii. Jest to równowazne przyjęciu, że $f(\vec{k}) = f_0(\vec{k} - \vec{\delta})$ (np. przykładamy pole \vec{E} i kula Fermiego przesuwa się o $\vec{\delta}$). $f(\vec{k}) = f_0(\vec{k} - \vec{\delta}) = f_0(\vec{k}) - \frac{\partial f_0}{\partial E} \nabla_{\vec{k}} E \cdot \vec{\delta} = f_0(E) + \vec{v} \cdot \vec{X}(E)$

 $(\nabla_{\vec{k}}E = \hbar\vec{v})$

Równanie Boltzmana
$rac{\partial f}{\partial t} = -ec{v}\cdot abla_{ec{r}}f - rac{1}{\hbar}ec{F}\cdot abla_{ec{k}}f + b - a$
$ \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial t} \end{pmatrix}_{zd} = -\frac{1}{4\pi^3} \frac{\hbar}{m^*} \int_{SB} W(\vec{k}, \vec{k}') \vec{X}(E) [\vec{k} - \vec{k}'] d^3 \vec{k}' $ Właściwości $W(\vec{k}, \vec{k}'):$ • Zakładamy, że proces rozpraszania jest izotropowy (nie zawsze!)
• Zderzenia są elestyczne $ \vec{k} = \vec{k}' $ $W(\vec{k}, \vec{k}') = \delta(\vec{k} - \vec{k}')\Theta(k, \theta)$, gdzie θ – kąt między \vec{k} i \vec{k}' .
Całkujemy w zmiennych sferycznych (składowa $\perp ec{k}$ po wycałkowaniu po $arphi$ daje 0)
$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{zd} = -\frac{1}{4\pi^3} \frac{\hbar}{m^*} \int_{BZ} W(\mathbf{k},\mathbf{k}') \mathbf{X}(E) \left(\mathbf{k}-\mathbf{k}'\right) d_3 \mathbf{k}' = -\frac{1}{4\pi^3} \frac{\hbar}{m^*} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\pi} \frac{\delta(k-k')}{\delta(k-k')} \Theta(k,\mathcal{G}) \mathbf{X}(E) \left(\mathbf{k}-\mathbf{k}'\right) k^2 \sin \mathcal{G} d\varphi d\mathcal{G} dk = -\frac{1}{4\pi^3} \frac{\hbar}{m^*} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} \frac{\delta(k-k')}{\delta(k-k')} \Theta(k,\mathcal{G}) \mathbf{X}(E) \left(\mathbf{k}-\mathbf{k}'\right) k^2 \sin \mathcal{G} d\varphi d\mathcal{G} dk = -\frac{1}{4\pi^3} \frac{\hbar}{m^*} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} \frac{\delta(k-k')}{\delta(k-k')} \Theta(k,\mathcal{G}) \mathbf{X}(E) \left(\mathbf{k}-\mathbf{k}'\right) k^2 \sin \mathcal{G} d\varphi d\mathcal{G} dk = -\frac{1}{4\pi^3} \frac{\hbar}{m^*} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} \frac{\delta(k-k')}{\delta(k-k')} \Theta(k,\mathcal{G}) \mathbf{X}(E) \left(\mathbf{k}-\mathbf{k}'\right) k^2 \sin \mathcal{G} d\varphi d\mathcal{G} dk = -\frac{1}{4\pi^3} \frac{\hbar}{m^*} \int_{0}^{\infty} \frac{\delta(k-k')}{\delta(k-k')} \Theta(k,\mathcal{G}) \mathbf{X}(E) \left(\mathbf{k}-\mathbf{k}'\right) k^2 \sin \mathcal{G} d\varphi d\mathcal{G} dk = -\frac{1}{4\pi^3} \frac{\hbar}{m^*} \int_{0}^{\infty} \frac{\delta(k-k')}{\delta(k-k')} \Theta(k,\mathcal{G}) \mathbf{X}(E) \left(\mathbf{k}-\mathbf{k}'\right) k^2 \sin \mathcal{G} d\varphi d\mathcal{G} dk = -\frac{1}{4\pi^3} \frac{\hbar}{m^*} \int_{0}^{\infty} \frac{\delta(k-k')}{\delta(k-k')} \Theta(k,\mathcal{G}) \mathbf{X}(E) \left(\mathbf{k}-\mathbf{k}'\right) k^2 \sin \mathcal{G} d\varphi d\mathcal{G} dk$
$= \frac{\hbar}{2\pi^2} \frac{\pi}{m^*} \int_0^{\pi} \Theta(k, \vartheta) \mathbf{X}(E) \mathbf{k} (\cos \vartheta - 1) k^2 \sin \vartheta d d\vartheta = \frac{\hbar}{2\pi^2} \frac{\mathbf{X}(E) \mathbf{k}}{m^*} \frac{\pi}{0} \Theta(k, \vartheta) (\cos \vartheta - 1) k^2 \sin \vartheta d d\vartheta$
R. Stępniewski.
2013-06-02 35

	$rac{\partial f}{\partial t} = -ec{v}\cdot abla_{ec{r}}f - rac{1}{\hbar}ec{r}\cdot abla_{ec{k}}f + b - a$
Dostaiemy	$f(\vec{k}) = f_0(\vec{k} - \vec{\delta}) = f_0(\vec{k}) - \frac{\partial f_0}{\partial E} \nabla_{\vec{k}} E \cdot \vec{\delta} = f_0(E) + \vec{v} \cdot X(E)$
2000030117	$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{zd} = -\int_{SB} W(\vec{k}, \vec{k}') \rho(\vec{k}') [f(\vec{k}) - f(\vec{k}')] d^{3}\vec{k}'$
	$= -\int W(\vec{k},\vec{k}')\rho(\vec{k}')\vec{X}(E)[\vec{v}(\vec{k})-\vec{v}(\vec{k}')]d^{3}\vec{k}'$
Dla pasma para	abolicznego i sferycznego $ ho(ec{k})=rac{2}{(2\pi)^3}=rac{1}{4\pi^3}$ oraz $ec{v}=rac{\hbar}{m^*}ec{k}$
	$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{zd} = -\frac{1}{4\pi^3} \frac{\hbar}{m^*} \int_{SB} W(\vec{k}, \vec{k}') \vec{X}(E) [\vec{k} - \vec{k}'] d^3 \vec{k}'$

	$dt \qquad h \qquad h$
	$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right) = \frac{\partial f X(E)}{2\pi^2} \left(\Theta(k,\theta)(\cos\theta - 1)k^2 \sin\theta d\theta \right)$
	$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{zd} \equiv \frac{f_1}{\tau(E)} = f_1 \cdot \frac{1}{2\pi^2} \int_{\Omega} \Theta(k,\theta) (\cos\theta - 1)k^2 \sin\theta d\theta \overrightarrow{k} \qquad \qquad$
$\tau(E)$ - to cza	s relaksacji – po wyłączeniu przyczyny zaburzenia funkcji rozkładu:
	$f_1(t) = f_1(0)e^{-\frac{t}{\tau(E)}}$
zmaleje e-ra:	zy
W tym przyb	liżeniu równanie Boltzmana ma postać:
	$\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f + \frac{1}{\kappa} \vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + \frac{f_1}{\sigma(E)} = 0$
Gdzie $f_1 = f$	$f = f_0$.





M. Ba

M. Ba

Równanie Boltzmana

2013-06-02

W ogólności zależności $\tau(E)$ dla różnych mechanizmów rozpraszania mogą być skomplikowane (np.: B.M. Askerov, *"Electron transport phenomena in semiconductors"*, World Scientific 1994, D. K. Ferry, *"Semiconductor transport"*, Taylor & Francis 2000).

Dla **pasma parabolicznego** w wielu przypadkach czas relaksacji daje się opisać zależnością potęgową od energii:

$$\tau(E) = \tau_{0,r}(T) \left(\frac{E}{k_B T}\right)^{\left(r-\frac{1}{2}\right)}$$

 $l_{tr}(E) = v\tau \sim E^{\frac{1}{2}}E^{\left(r-\frac{1}{2}\right)} = E^r$

Czynnik $\tau_{0,r}(T)$ zalezy od temperatury z powodu:

• wyłączenia $k_B T$ we wzorze opisującym $\tau(E)$

dodatkowej zależności – np. poprzez liczbę fononów

Jeśli półprzewodnik jest niezdegenerowany i można stosować rozkład Boltzmanna, to $\langle E \rangle \sim k_B T \tau$ zależy od temperatury wyłącznie poprzez czynnik $\tau_{0,r}(T)$



fonony akustyczne	p=0	$\tau(E) = A E^{-\frac{1}{2}}$	E – rośnie ⇒τ- maleje	
neutralne domieszki fonony optyczne (dla E>>Et) (problem z wprowadzeniem	p=1/2 p=1	$\tau(E) = A$ $\tau(E) = A E^{\frac{1}{2}}$	τ- stałe E – rośnie ⇒τ- rośnie	
pojęcia czasu relaksacji pędowej – istotna zmiana energii) zjonizowane domieszki	p=2	$\tau(E) = A E^{\frac{3}{2}}$	E – rośnie ⇒t- rośnie	

Scattering mechanism	Scattering parameter r	$\tau_{0r}(T)$	Aor
Point defects (short-range potential)	0	$\frac{\pi \hbar^4}{m_{\rm m}(2m_{\rm m}k_0T)^{1/2}U_0^2N_{\rm g}}$	$\frac{\pi}{\hbar}U_0^2N_g$
Acoustic phonons (deformation potential)	0	$\frac{2\pi\hbar^4\rho v_0^2}{E_1^2(2m_{\rm s}k_0T)^{3/2}}$	$\frac{\pi E_1^2 k_0 T}{\hbar \rho v_0^2}$
Nonpolar optical phonons at high temperatures $(k_0 T \gg \hbar \omega_0)^*$	0	$\frac{2}{\pi} \left(\frac{\hbar\omega_0}{E_0}\right)^2 \frac{\hbar^2 a^2 \rho}{(2m_{\rm s}k_0 T)^{3/2}}$	$\pi^{3}\hbar \left(\frac{E_{0}}{\hbar\omega_{0}}\right)^{2}\frac{k_{0}T}{\rho a^{2}}$
Polar optical phonons at high temperatures $(k_0 T \gg \hbar \omega_0)$	I	$\frac{1}{2\alpha} \left(\frac{\hbar}{\omega_0 k_0 T} \right)^{1/2}$	$\frac{2\pi^2 e^2 k_0 T}{\varkappa^* \hbar}$
Piezoacoustic phonons	1	$\frac{2\pi\hbar^2\varkappa}{e^2\Pi_0^2} \left(\frac{2}{m_{\rm s}k_0T}\right)^{1/2}$	$\frac{\pi e^2 k_0 T \Pi_0^2}{2\hbar\varkappa}$
Impurity ions	2	$\frac{\varkappa^2 (2m_{\pi})^{1/2} (k_0 T)^{3/2}}{\pi e^4 N_i F_{imp}(\varepsilon)}$	$\frac{2\pi^3 N_i F_{imp}(k)}{\hbar \varkappa^2}$

Równanie Boltzmana	1
Wnioski – TRANSPORT DYFUZYJNY:	
$\frac{\partial f}{\partial t} = -\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f - \frac{1}{\hbar} \vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + b - a$	
$W(\vec{k}, \vec{k}') = \delta(\vec{k} - \vec{k}')\Theta(k, \theta)$, gdzie θ – kąt między \vec{k} i \vec{k}' .	
$\frac{1}{\tau(E)} = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^{\pi} \Theta(k,\theta) (\cos\theta - 1)k^2 \sin\theta \ d\theta$	
$f_1(t) = f_1(0)e^{-\frac{t}{\tau(E)}}$	
$\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f + \frac{1}{\hbar} \vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + \frac{f_1}{\tau(E)} = 0$	
Pole elektryczne:	
Pole elektryczne $ec{F}=qec{arepsilon}$ dla ładunku $q=\pm e$	
zakładamy, że układ jest jednorodny w całej swojej objętości: $ abla_{ec r} f = 0$	
$f(\vec{k}) = f_0(\vec{k} - \vec{\delta}) = f_0(\vec{k}) - \frac{\partial f_0}{\partial E} \nabla_{\vec{k}} E \cdot \vec{\delta} = f_0(E) + \vec{v} \cdot \vec{X}(E)$	
$\nabla_{\overline{z}} f = \nabla_{\overline{z}} (f_0 + f_1) = \frac{\partial f_0}{\partial \overline{z}} \nabla_{\overline{z}} E + \nabla_{\overline{z}} f_1$	
$\partial E^{(k)} = \partial E^{(k)} + \partial E^{(k)} + \partial E^{(k)}$	M. Baj
2013-06-02	43



Równani	e Boltzmana
Wnioski – TRANSPOF	RT DYFUZYJNY:
	$\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f + \frac{1}{\hbar} \vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + \frac{f_1}{\tau(E)} = 0$
Pole elektryczne:	
 Pole elektryczne [#] 	$\vec{r} = q \vec{\mathcal{E}}$ dla ładunku $q = \pm e$
 zakładamy, że ukła 	ad jest jednorodny w całej swojej objętoś <u>ci: $abla_{ec{r}}f=0$, wprow</u> adziliśmy
$f(\vec{k}$	$) = f_0(\vec{k} - \vec{\delta}) = f_0(\vec{k}) - \frac{\partial f_0}{\partial E} \nabla_{\vec{k}} E \cdot \vec{\delta} = \left f_0(E) + \vec{v} \cdot \vec{X}(E) \right $
	$\nabla_{\vec{k}}f = \nabla_{\vec{k}}(f_0 + f_1) = \frac{\partial f_0}{\partial E} \nabla_{\vec{k}}E + \nabla_{\vec{k}}f_1$
Człon:	
	$\frac{1}{\hbar}\vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}}f = \frac{1}{\hbar}q\vec{\epsilon} \cdot \left(\frac{\partial f_0}{\partial E}\nabla_{\vec{k}}E + \nabla_{\vec{k}}f_1\right)$
	Odrzucamy człony nieliniowe w zaburzeniu
(odrzucamy człony ni Boltzmana dostawali	eliniowe w zaburzeniu, bo zaraz pokażemy, że $f_1 \propto \vec{\epsilon}$ i byśmy z równania
$\propto \vec{E}^2$.	zjawiska zalezące nie tyrku mnowo od 2 (np. prawo Onina) także człony

2013-06-02

Wnioski – TRANSPORT DYFUZYJNY:

 $\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f + \frac{1}{\hbar} \vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + \frac{f_1}{\tau(E)} = 0$

Pole elektryczne:

- Pole elektryczne $\vec{F} = q \vec{\mathcal{E}}$ dla ładunku $q = \pm e$
- zakładamy, że układ jest jednorodny w całej swojej objętości: $\nabla_{\vec{r}} f = 0$, wprowadziliśmy

$$\begin{split} f(\vec{k}) &= f_0(\vec{k} - \vec{\delta}) = f_0(\vec{k}) - \frac{\partial J_0}{\partial E} \nabla_{\vec{k}} E \cdot \vec{\delta} = \begin{bmatrix} f_0(E) + \vec{v} \cdot \vec{X}(E) \end{bmatrix} \\ \nabla_{\vec{k}} f &= \nabla_{\vec{k}} (f_0 + f_1) = \frac{\partial f_0}{\partial E} \nabla_{\vec{k}} E + \frac{\nabla_{\vec{k}} f_1}{\mathcal{A}} \quad (*) \end{split}$$

Stąd

$$f_1 = q \cdot \tau(E) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) \vec{\mathcal{E}} \cdot \vec{\mathcal{v}} = \vec{\mathcal{v}} \cdot \vec{X}(E)$$

 $0 + \frac{q}{\hbar}\vec{\varepsilon} \cdot \frac{\partial f_0}{\partial E} \nabla_{\vec{k}} E + \frac{f_1}{\tau(E)} = \overline{\frac{q}{\hbar}\vec{\varepsilon}} \cdot \frac{\partial f_0}{\partial E} \hbar \vec{v} + \frac{f_1}{\tau(E)} = 0$

Czyli f_1 zależy od pola $\vec{\mathcal{E}}$. Równanie różniczkowe na f (*) można dalej rozwiązywać iteracyjnie znajdując człony proporcjonalne do $\vec{\mathcal{E}}^2$, $\vec{\mathcal{E}}^3$, $\vec{\mathcal{E}}^4$ itd. 2013-06-02

EXAMPLEDESCRIPTION \widehat{U} by \widehat{U} \widehat{U}



Wnioski –	TRANSPORT DYFUZ	YINY:		
		$\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f + \frac{1}{\hbar} \vec{F} \cdot \nabla$	$\frac{f_1}{k}f + \frac{f_1}{\tau(E)} = 0$	
Pole elekt	yczne:			
• $f_1 = q$	$\tau(E)\left(-\frac{\partial f_0}{\partial E}\right)\vec{E}\cdot\vec{v}$			
gęstość pr równowag	ądu można policzyć owa nie daje wkładu	licząc całkę po całej u do prądu):	strefie Brillouina z fu	unkcją f_1 (f_0 jako funkcja
	$\vec{j} = \int_{SB} q \vec{v} \cdot f_1 \cdot f_2$	$\rho(\vec{k})d^3k = \frac{1}{4\pi^3} \int_{SB}$	$q \vec{v} \cdot q \cdot \tau(E) \left(-\frac{\partial f}{\partial E} \right)$	$\left(\frac{\vec{v}}{d}\right)\vec{\vec{v}}\cdot\vec{\vec{v}}\cdot d^3k$ Znika prąd $\vec{\vec{v}}\perp\vec{\vec{v}}$
wprowadz natężenia	ając układ współrzę pola elektrycznego,	dnych sferycznych z wykonując całkowa	osią biegunową skie nia po kątach i zamie	rowaną wzdłuż wektora eniając zmienną
całkowani	a z k na Ł (<u>w przybli</u>	zeniu pasma sferyc	<u>znego</u> , κ ∥ ν, biorąc	$v = \frac{1}{\hbar} v_{\vec{k}} E$) otrzymujemy:
Przy	tablicy! $\vec{J} = \frac{e}{n}$	$\frac{e^2}{n^*} \left[\frac{1}{3\pi^2} \int_{SB} \tau(E) \left(-\frac{1}{2\pi^2} \int_{SB} \tau(E) \right) \right]$	$-\frac{\partial f_0}{\partial E}\bigg)k^3(E)\cdot dE\bigg]\cdot$	$\vec{\epsilon}$ $\vec{\epsilon}$ $\vec{\epsilon}$ \vec{k}
$\int_0^{\pi} \sin x dx$				



Równanie Boltzmana
Wnioski – TRANSPORT DYFUZYJNY:
$\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f + \frac{1}{\hbar} \vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + \frac{f_1}{\tau(E)} = 0$
Pole elektryczne:
$\vec{J} = \frac{e^2}{m^*} \left[\frac{1}{3\pi^2} \int_{SB} \tau(E) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) k^3(E) dE \right] \cdot \vec{E}$ Wartość średnia (przypomnienie):
$ \langle \tilde{A} (E) \rangle = \frac{\frac{1}{3\pi^2} \int_0^\infty A(E) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) k^3(E) dE}{\frac{1}{3\pi^2} \int_0^\infty \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) k^3(E) dE} $ $ \frac{1}{3\pi^2} \int_0^\infty \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) k^3(E) dE = n \qquad \qquad$
$(A(E)) = \frac{1}{n} = \frac{1}{3\pi^2 n} \int_{0}^{1} A(E) \left(-\frac{1}{\partial E}\right) k^{-1}(E) dE$
$ig \langle ilde{A}(E) ig angle$ jest to wielkość $\langle A(E) angle$ przypadająca na jeden elektron
2013-06-02 51

$(1) = \frac{1}{3\pi^2} \int_0^\infty 1 \cdot \left(-\frac{1}{\pi^2} \int_0^\infty f_0^{-1} dt \right)$ = 0 + $\frac{1}{\pi^2} \int_0^\infty f_0^{-1} dt = 0$ bo $f_0(\infty) = 0, k^3(0) = 0$	$\frac{1}{3\pi^2} \int_0^\infty \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) k^3(E) dE = n \qquad \qquad$
--	---

Wnioski – TRANS	PORT DYFUZYINY: $\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f + \frac{1}{\hbar} \vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + \frac{f_1}{\tau(E)} = 0$
Pole elektryczne:	
	$\vec{j} = \frac{e^2}{m^*} \left[\frac{1}{3\pi^2} \int_{SB} \tau(E) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) k^3(E) dE \right] \cdot \vec{E}$
Wartość średnia (przypomnienie):
	$\langle A(E) \rangle = \frac{\frac{1}{3\pi^2} \int_0^\infty A(E) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) k^3(E) dE}{4\pi^2 (-2E)^{1/2}}$
	$\frac{1}{3\pi^2} \int_0^\infty \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) k^3(E) dE$
	$\langle \tilde{\tau}(E) \rangle = \frac{\langle \tau(E) \rangle}{n} = \frac{1}{3\pi^2 n} \int_0^\infty \tau(E) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) k^3(E) dE$
	$\vec{I} = \frac{e^2}{2} \langle \tau(E) \rangle \cdot \vec{E} = \frac{e^2 n}{2} \langle \tilde{\tau}(E) \rangle \cdot \vec{E} \equiv \sigma \cdot \vec{E}$

Pole elektryczne:

$$\vec{j} = \frac{e^2}{m^*} \langle \tau(E) \rangle \cdot \vec{\mathcal{E}} = \frac{e^2 n}{m^*} \langle \tilde{\tau}(E) \rangle \cdot \vec{\mathcal{E}} \equiv \sigma \cdot \vec{\mathcal{E}}$$

Zatem przewodnictwo σ :

$$\sigma = n \frac{e^2}{m^*} \langle \tilde{\tau}(E) \rangle = n e \mu \implies \mu = \frac{e}{m^*} \langle \tilde{\tau}(E) \rangle$$

W przypadku metalu $\frac{\partial f_0}{\partial E} \approx -\delta(E - E_F)$ i wtedy $\mu = \frac{e}{m^*} \tau(E_F)$

- w przypadku niezdegenerowanym w niskich temperaturach można się spodziewać $\mu(T) \sim T^{3/2}$ (rozpraszanie zdominowane przez zjonizowane domieszki)
- w przypadku niezdegenerowanym w wysokich temperaturach można się spodziewać $\mu(T) \sim T^{-3/2}$ (jeśli rozpraszanie zdominowane przez fonony akustyczne, potencjał deformacyjny)





Tensor przewodnictwa
Tensor przewodnictwa: $\vec{j}_{sw} = \partial \vec{E}$ Tensor oporności: $\vec{E} = \hat{\rho} \vec{j}_{sw}$
$\begin{pmatrix} J_x \\ J_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix}$
Tensor przewodnictwa: $\vec{j}_{sw} = \hat{\sigma}\vec{E}$ W ośrodku izotropowym $J_x = \sigma_{xx}E_x$
Równanie Boltzmana: $\vec{v}\cdot abla_{\vec{r}}f + rac{1}{\epsilon}\vec{F}\cdot abla_{\vec{k}}f + rac{f_1}{-(r)} = 0$
w obecności pól elektrycznego i magnetycznego w układzie jednorodnym ($\nabla_{\vec{r}}f = 0$) ma postać: $0 + \frac{1}{\hbar} [\vec{E} + (\vec{v} \times \vec{B})] \cdot \nabla_{\vec{k}}f + \frac{\vec{v} \cdot \vec{X}(E)}{\tau(E)} = 0$
Rozwiązanie \vec{X} daje $\vec{X} = \frac{\vec{X}_0 + s(\vec{X}_0 \times \vec{b}) + s^2 \vec{b}(\vec{b} \cdot \vec{X}_0)}{1 + s^2}$
Dla wersora w kierunku pola $\vec{b} = \vec{B}/B$, $s = q\tau B/m^*(q = \pm e)$, Rozwiązanie bez pola $\vec{X}_0 = q\tau \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E}\right) \vec{\mathcal{E}}$
2013-06-02 56

Provide a constraint of the set of the set

Tensor przewodnictwa
$s=rac{q au B}{m^*}\equiv\omega_c au,\qquad q=\pm e$ $s\gg 1-$ silne pola ω_c - czestość cyklotronowa
$\hat{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0\\ -\sigma_{yx} & \sigma_{xx} & 0\\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix} = \frac{ne^2}{m^*} \begin{pmatrix} \left(\frac{\tau}{1+s^2}\right) & \left(\frac{s\tau}{1+s^2}\right) & 0\\ \left(\frac{-s\tau}{1+s^2}\right) & \left(\frac{\tau}{1+s^2}\right) & 0\\ 0 & 0 & (\tau) \end{pmatrix}$
$\sigma_{xy} = \frac{ne^2}{m^*} \left(\frac{s\tau}{1+s^2}\right)$ może być dodatnie albo ujemne, σ_{zz} nie zależy od pola magnetycznego.
Dla silnych pól $s \gg 1$ $\sigma_{xx} = \frac{ne^2}{m^*} \left(\frac{\tau}{1+s^2}\right) \approx \frac{ne^2}{m^*} \left(\frac{\tau}{s^2}\right) = \frac{nm^*}{B^2} \left(\frac{1}{\tau}\right)$
Czyli σ_{xx} maleje w polu $\sigma_{xy} = \frac{ne^2}{m^*} \left\langle \frac{s\tau}{1+s^2} \right\rangle \approx \frac{ne^2}{m^*} \left\langle \frac{\tau}{s} \right\rangle = \frac{qn}{B}$ Czyli σ_{xy} jest liniowe w polu.
2012 07 02

	$s = rac{q au B}{m^*} \equiv \omega_c au, \qquad q = \pm e$
$s \ll 1 - stabe$	e pola
$s \gg 1 - {\rm silne}$	pola
ω_c - częstość	cyklotronowa
	$\hat{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0\\ -\sigma_{yx} & \sigma_{xx} & 0\\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix} = \frac{ne^2}{m^*} \begin{pmatrix} \frac{\tau}{(1+s^2)} & \left(\frac{s\tau}{(1+s^2)} & 0\right)\\ \left(\frac{-s\tau}{(1+s^2)} & \left(\frac{\tau}{(1+s^2)} & 0\right)\\ 0 & 0 & \langle \tau \rangle \end{pmatrix}$
$\sigma_{xy} = \frac{ne^2}{m^*} \left\langle \frac{s}{1+s} \right\rangle$	$\left(\frac{r}{s^2}\right)$ może być dodatnie albo ujemne, σ_{zz} nie zależy od pola magnetycznego.
Dla słabych p	ól s ≪ 1
	$\sigma_{xx} = \frac{ne^2}{m^*} \left(\frac{\tau}{1+s^2} \right) \approx \frac{ne^2}{m^*} \left\langle \tau \left(1 - s^2 + 0(s^4) \right) \right\rangle = \frac{ne^2}{m^*} \left[\langle \tau \rangle - \omega_c^2 \langle \tau^3 \rangle \right]$
Czyli σ_{xx} nie :	alezy od pola + dodatek kwadratowy
	$\sigma_{xy} = \frac{ne^2}{m^*} \left(\frac{s\tau}{1+s^2} \right) \approx \frac{ne^2}{m^*} \langle \tau s \rangle = \frac{ne^2}{m^*} \omega_c \langle \tau^2 \rangle$
Czyli σ_{xy} jest	liniowe w polu.







Efekt Halla

 $\sigma_{xy} \ll \sigma_{xx}$:

Oporność poprzeczna $\rho_H = R_H \cdot B$ gdzie R_H współczynnik Halla.

Współczynnik Halla w obszarze niskich pól magnetycznych $B \rightarrow 0$













M. Baj.

Efekt Gaussa

Magnetoopór poprzeczny – efekt Gaussa

słowo "poprzeczny" odnosi się do sytuacji, kiedy przepływ prądu zachodzi w kierunku prostopadłym do kierunku pola magnetycznego

zjawiskiem magnetooporu nazywamy względną zmianę oporności ρ_{xx} w funkcji pola magnetycznego

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\rho_{xx}}{\rho_0} - 1 = \frac{\sigma(0)\sigma_{xx} - \sigma_{xx}^2 - \sigma_{xy}^2}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2}$$

magnetoopór w obszarze niskich pól magnetycznych $s \ll 1$: stosując standardowe przybliżenia i ograniczając się do wyrazów najniższego rzędu w Botrzymujemy:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \omega_c^2 \left[\frac{\langle \tau^3 \rangle}{\langle \tau \rangle} - \frac{\langle \tau^2 \rangle^2}{\langle \tau \rangle^2} \right] = \mu^2 B^2 \left[\frac{\langle \tau^3 \rangle}{\langle \tau \rangle^3} - \frac{\langle \tau^2 \rangle^2}{\langle \tau \rangle^4} \right] = \mu^2 B^2 \cdot A$$

magnetopór jest kwadratowy w B

jest proporcjonalny do μ²

• współczynnik proporcjonalności A zależy od mechanizmu rozpraszania: np. w przypadku niezdegenerowanym (rozkład Boltzmanna) dla p = 0 (fonony akustyczne, potencjał deformacyjny) A = 0,13, dla p = 2 (zjonizowane domieszki) A = 2,41 M. Baj

2013-06-02

Efekt Gaussa

Magnetoopór poprzeczny – efekt Gaussa

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\rho_{xx}}{\rho_0} - 1 = \frac{\sigma(0)\sigma_{xx} - \sigma_{xx}^2 - \sigma_{xy}^2}{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{xy}^2}$$

magnetoopór w obszarze wysokich pól magnetycznych $s \gg 1$:

$$\frac{\Delta \rho_{\infty}}{\rho} = \frac{\sigma(0)\sigma_{xx}}{\sigma_{xy}^2} - 1 = \langle \tau \rangle \left\langle \frac{1}{\tau} \right\rangle - 1$$

magnetopór nasyca się na wartości zależnej od mechanizmu rozpraszania. Dla rozkładu Boltzmana:

• dla p = 0 (fonony) dostajemy $\frac{\Delta \rho_{\infty}}{\rho} = 0,38$

• dla p = 2 (zjonizowane domieszki) dostajemy $\frac{\Delta \rho_{\infty}}{\rho} = 2,98$

W przypadku pasma sferycznego magnetoopór podłużny nie pojawia się (na ładunek poruszający się wzdłuż linii pola B nie działa siła). W przypadku pasma niesferycznego przewodnictwo jest tensorowe nawet bez pola B i w tym przypadku magnetoopór podłużny występuje.

efekt Halla – pierwszego rzędu w polu B

efekt Gaussa – drugiego rzędu w polu B

2013-06-02

Tensor przewodnictwa

Wiele rodzajów nośników:

- półprzewodnik bliski samoistnemu w transporcie biorą udział elektrony w paśmie przewodnictwa i dziury w paśmie walencyjnym
- degeneracja kilku dolin jednego pasma nośniki obsadzające różne doliny mają różne koncentracje i ruchliwości
- heterostruktura w której występuje kilka warstw zawierających różne swobodne nośniki

Standardowym założeniem jest to, że każda *i*-ta "grupa" nośników czuje ten sam rozkład pola elektrycznego oraz że nośniki w swoim ruchu sobie nawzajem "nie przeszkadzają". W takim przypadku, całkowita gęstość prądu jest sumą gęstości prądu od poszczególnych grup nośników *i*: tzn. tensor przewodnictwa jest addytywny:





Tensor przewodnictwa Wiele rodzajów nośników, przykłady: $R_{H0} = \frac{j_x}{E_x B} = \frac{1}{|e|} \frac{r_h p \mu_h^2 - r_e n \mu_c^2}{(n \mu_c + p \mu_h)^2} \xrightarrow{r_h = r_e = r} \frac{r}{e} \frac{p - nb^2}{(p + nb)^2}$ W dużych polach $s_e, s_h \gg 1$: $R_{H\infty} = \frac{1}{e(p-n)}$ W małych polach magnetycznych dominujący wkład do współczynnika Halla mogą mieć nośniki bardziej ruchliwe, nawet jeśli ich koncentracja jest istotnie mniejsza. W wysokich polach magnetycznych o znaku współczynnika Halla decydują nośniki o większej koncentracji. Z powyższego wynika, że znak współczynnika Halla może w funkcji pola B się zmienić M. Baj

Tensor przewodnictwa
Widmo ruchliwości:
$s_{i} = \frac{q_{i}\tau_{i}}{m_{i}^{*}}B \equiv \mu_{i}B$ $\sigma_{xx}^{i}(B) = \frac{e^{2}n_{i}}{m_{i}^{*}}\frac{\tau_{i}}{1+s_{i}^{2}} = \frac{\sigma_{0i}}{1+s_{i}^{2}} = \frac{\sigma_{0i}}{1+(\mu_{i}B)^{2}}$ $\sigma_{xy}^{i}(B) = \frac{\sigma_{0i}}{1+(\mu_{i}B)^{2}} \cdot (\mu_{i}B)$
Sumaryczny wkład od wszystkich kanałów przewodnictwa (grup nośników):
$\sigma_{xx}^{tot}(B) = \sum_{i} \frac{\sigma_{0i}}{1 + (\mu_i B)^2} = \int_{\mu} \left(\frac{d\sigma_0(\mu)}{d\mu} \right) \frac{1}{1 + (\mu B)^2} d\mu$
$\sigma_{xy}^{tot}(B) = \sum_{i} \frac{\sigma_{0i}}{1 + (\mu_{i}B)^{2}} \cdot (\mu_{i}B) = \int_{\mu} \left(\frac{d\sigma_{0}(\mu)}{d\mu}\right) \frac{\mu B}{1 + (\mu B)^{2}} d\mu$
Rozwiązanie problemu polega na takim dobraniu wkładów poszczególnych kanałów przewodnictwa , aby zgodność pomiędzy wyliczonymi zależnościami i i doświadczeniem była jak
М. Вај
2013-06-02 75



Widmo ruch Sumaryczny v	l iwości: /kład od wszystkich kanałów przewodnictwa (grup nośników):
$\sigma_{xx}^{tot}(B) = \sum_{i}^{}$	$\int_{\mu} \frac{\sigma_{0i}}{1 + (\mu_i B)^2} = \int_{\mu} \left(\frac{d\sigma_0(\mu)}{d\mu} \right) \frac{1}{1 + (\mu B)^2} d\mu$
$\sigma_{xy}^{tot}(B) = \sum_{i}^{tot}$	$\int \frac{\sigma_{0i}}{1 + (\mu_i B)^2} \cdot (\mu_i B) = \int \left(\frac{d\sigma_0(\mu)}{d\mu} \right) \frac{\mu B}{1 + (\mu B)^2} d\mu$
Rozwiązanie p przewodnictw najlepsza.	problemu polega na takim dobraniu wkładów poszczególnych kanałów ra , aby zgodność pomiędzy wyliczonymi zależnościami i i doświadczeniem była jak
można albo p stosować kwa	róbować dopasować sumę wkładów od kilku kanałów $\mu_l - \sigma_{0l}$ przewodnictwa, albo ziciągły rozkład $rac{d\sigma_0(\mu)}{d\mu}$. Wyniku dostajemy tzw. widmo ruchliwości .



Tensor przewodnictwa

Układy niskowymiarowe:

Układy niskowymiarowe – uwięzienie kwantowe w r wymiarach (1, 2 lub 3) prowadzi do tego, że elektrony (dziury) mają swobodę ruchu tylko w pozostałych d = 3-r wymiarach \Rightarrow układy 2D, 1D, 0D

W przypadkach 2D i 1D transport równoległy (lateralny) w płaszczyźnie gazu 2D lub wzdłuż drutu kwantowego (w odróżnieniu np. do transportu poprzecznego, wertykalnego, w poprzek warstw heterostruktury), w przypadku kiedy $L \gg l_e$ (gdzie l_e – średnia droga swobodna) może być rozpatrywany w taki sam sposób jak transport dyfuzyjny w 3D – równanie Boltzmanna, przybliżenie czasu relaksacii, etc.

Różnice w stosunku do przypadku 3D:

1. wynikające z różnej, w zależności od wymiaru d, gęstości stanów

 różnych, w szczególności także takich, które nie występowały w układach 3D mechanizmów rozpraszania nośników

M. Bai



Tensor przewodnictwa

Układy niskowymiarowe:

w układach o różnej wymiarowości przy liczeniu prawdopodobieństwa rozpraszania (co doprowadziło nas w przypadku 3D do wyrażenia na czas relaksacji) trzeba teraz: wziąć gęstość stanów właściwą dla wymiarowości problemu policzyć prawdopodobieństwo rozpraszania z właściwymi funkcjami falowymi całkowania dokonać w przestrzeni *d-wymiarowej*

(2.5)

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{zd} = -\frac{\rho(k)}{m^*(k)} \int_{SB} \frac{\delta(k-k')\Theta(k,\theta)}{\delta(k-k')\Theta(k,\theta)} \vec{X}(E) \cdot (k-k') \, d^3k'$$

(W.13, slajd ok. 35)

2013-06-02

przy takim samym potencjale rozpraszającym w układach o różnej wymiarowości czasy relaksacji będą w inny sposób zależały od energii.

M. Baj.

Tensor przewodnictwa

Układy niskowymiarowe:

przy takim samym potencjale rozpraszającym w układach o różnej wymiarowości czasy relaksacji będą w inny sposób zależały od energii.

Przy liczeniu wartości średnich funkcji A(E) zależnych od energii, ze względu na wymiar przestrzeni d = 1,2,3 w której całkujemy będziemy mieli:

$$\left(\tilde{A}(E)\right)_{d} = \frac{\frac{1}{3\pi^{2}}\int_{0}^{\infty}A(E)\left(-\frac{\partial f_{0}}{\partial E}\right)k^{d}(E)\,dE}{\frac{1}{3\pi^{2}}\int_{0}^{\infty}\left(-\frac{\partial f_{0}}{\partial E}\right)k^{d}(E)\,dE}$$

Przy obniżeniu wymiarowości układu pojawiają się nieciągłości gęstości stanów, rośnie gęstość stanów na krawędzi podpasma ⇒ w 1D prawdopodobieństwo rozproszenia może mieć osobliwość.

Przy obniżaniu wymiarowości układu dramatycznie zmniejsza się liczba początkowych i końcowych stanów elektronowych w rozpraszaniu – w 1D w obrębie danego podpasma rozpraszanie elastyczne może prowadzić tylko do stanów z $k' = \pm k$ (do przodu albo do tyłu)

Różnice w ekranowaniu – potencjały są 3D, ekranowanie zaś odbywa się w obszarach *d*-wymiarowych M. Baj

2013-06-02

Zjawiska termoelektryczne
Siła termoelektryczna
$\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f_0 + \frac{1}{\hbar} q \vec{\varepsilon} \cdot \nabla_{\vec{k}} f_0 + \frac{f_1}{\tau(E)} = 0$ człon dyfuzyjny – zawiera gradient f_0 po współrzędnych przestrzennych
$\nabla_{\vec{r}}f_0 = \frac{\partial f_0}{\partial T}\nabla_{\vec{r}}T$
Wprowadzamy zmienną $\zeta = \frac{E - \xi(T)}{k_{\rm h}T}$, wtedy
$\frac{\partial f_0}{\partial T} = \frac{\partial f_0}{\partial \zeta} \left(-\frac{E-\xi(T)}{k_b T^2} - \frac{1}{k_b T} \frac{d\xi}{dT} \right) = \frac{\partial f_0}{\partial E} \left(-\frac{E-\xi(T)}{T} - \frac{d\xi}{dT} \right)$
Człon polowy
$rac{1}{\hbar}qec{arepsilon}\cdot arphi_{ec{k}}f_{0} = rac{1}{\hbar}iggl(rac{\partial f_{0}}{\partial E}iggr) arphi_{ec{k}}E\cdot qec{arepsilon} = q\left(rac{\partial f_{0}}{\partial E}iggr)ec{v}\cdotec{arepsilon}$
stąd otrzymujemy rozwiązanie na funkcję f_1 :
$f_1 = \tau \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E} \right) \vec{v} \cdot \left[q \vec{E} - \frac{E - \xi(T)}{T} \nabla_{\vec{r}} T - \frac{d\xi}{dT} \nabla_{\vec{r}} T \right]$
$\vec{j} = \int_{SR} q \vec{v} \cdot f_1 \cdot \rho(\vec{k}) d^3 k = \vec{j}_1 + \vec{j}_2 + \vec{j}_3$
2013-06-02 83

Zjawiska termoelektryczne

Siła termoelektryczna

2013-06-02

gradient temperatury i pole elektryczne, bez pola magnetycznego

funkcja rozkładu *musi* zależeć od położenia (gradient temperatury!) , od położenia będzie zależeć potencjał chemiczny

Równanie Boltzmanna

$$\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f + \frac{1}{\hbar} \vec{F} \cdot \nabla_{\vec{k}} f + \frac{f_1}{\tau(E)} = 0$$

 $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ Pomijamy f_1 w członie $\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f = \vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} (f_0 + f_1) \approx \vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f_0$, podobnie $\nabla_{\vec{k}} f \approx \nabla_{\vec{k}} f_0$

 $\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{r}} f_0 + \frac{1}{\hbar} q \vec{E} \cdot \nabla_{\vec{k}} f_0 + \frac{f_1}{\tau(E)} = 0$ człon dyfuzyjny – zawiera gradient f_0 po współrzednych przestrzennych

$$\nabla_{\vec{r}} f_0 = \frac{\partial f_0}{\partial T} \nabla_{\vec{r}} T$$

 f_0 zależy od temperatury poprzez zależność explicite od T oraz poprzez zależność poziomu Fermiego ξ od T:

$$f_0 = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - \xi(T)}{k_b T}}}$$

<text><equation-block><text><equation-block><text><equation-block><text><text><text><text><text>

Zjawiska termoelektryczne

Siła termoelektryczna

$$f_{1} = \tau \left(-\frac{\partial f_{0}}{\partial E} \right) \vec{v} \cdot \left[q\vec{E} - \frac{E - \xi(T)}{T} \nabla_{\vec{r}} T - \frac{d\xi}{dT} \nabla_{\vec{r}} T \right]$$
$$\vec{j} = \int_{SB} q\vec{v} \cdot f_{1} \cdot \rho(\vec{k}) d^{3}k = \vec{j}_{1} + \vec{j}_{2} + \vec{j}_{3}$$
$$\vec{j} = \frac{e^{2}n\langle \tau \rangle}{m^{*}} \left[\vec{E} - \frac{k_{B}}{q} \left[\frac{\langle \varepsilon \tau \rangle}{\langle \tau \rangle} - \eta \right] \cdot \nabla_{\vec{r}} T - \frac{1}{q} \nabla_{\vec{r}} \xi \right]$$

jeśli mierzymy pojawiającą się na końcach próbki różnicę potencjałów przy braku przepływu prądu, to j=0:

$$\vec{\mathcal{E}} - \frac{k_B}{q} \left[\frac{\langle \mathcal{E} \tau \rangle}{\langle \tau \rangle} - \eta \right] \cdot \nabla_{\vec{r}} T - \frac{1}{q} \nabla_{\vec{r}} \xi = 0$$

zjawisko występowania pola elektrycznego w materiale, wskutek występowania gradientu temperatury nazywa się zjawiskiem Seebecka (siłą termoelektryczną).

Natężenie pola elektrycznego w powyższym wzorze nie jest wielkością, którą się bezpośrednio mierzy poprzez dołączenie 2 kontaktów umieszczonych na próbce wzdłuż gradientu temperatury i zmierzenie napięcia elektrycznego między nimi!

2013-06-0